

## SN74AHC1G32-Q1 汽车类单路 2 输入正或门

### 1 特性

- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准：
  - 器件温度等级 1：-40°C 至 +125°C
  - 器件 HBM ESD 分类等级 2
  - 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
- 符合汽车应用要求
- 工作电压范围为 2V 至 5.5V
- 5V 时， $t_{pd}$  最大值为 6.5ns
- 低功耗， $I_{CC}$  最大值为 10  $\mu$ A
- 5V 时，输出驱动为  $\pm 8$ mA
- 闩锁性能超过 250mA，符合 JESD 17 规范

### 2 应用

- 启用或禁用数字信号
- 控制指示灯 LED

### 3 说明

SN74AHC1G32-Q1 是一款单路 2 输入正或门。器件以正逻辑执行布尔函数  $Y = A + B$ 。

#### 封装信息

器件型号	封装 <sup>(1)</sup>	封装尺寸 <sup>(2)</sup>	本体尺寸 <sup>(3)</sup>
SN74AHC1G32-Q1	DBV ( SOT-23 , 5 )	2.9mm × 2.8mm	2.9mm × 1.6mm
	DCK ( SC70 , 5 )	2mm × 1.25mm	2mm × 1.25mm
	DTX ( X2SON , 5 )	1.1mm × 0.85mm	1.1mm × 0.85mm

- 如需了解更多信息，请参阅[机械、封装和可订购信息](#)。
- 封装尺寸（长 × 宽）为标称值，并包括引脚（如适用）。
- 本体尺寸（长 × 宽）为标称值，不包括引脚。



逻辑图（正逻辑）



## 内容

<b>1 特性</b> .....	1	7.3 特性说明.....	7
<b>2 应用</b> .....	1	7.4 器件功能模式.....	8
<b>3 说明</b> .....	1	<b>8 应用和实施</b> .....	9
<b>4 引脚配置和功能</b> .....	3	8.1 应用信息.....	9
<b>5 规格</b> .....	4	8.2 典型应用.....	9
5.1 绝对最大额定值.....	4	8.3 电源相关建议.....	10
5.2 ESD 等级.....	4	8.4 布局.....	10
5.3 建议运行条件.....	4	<b>9 器件和文档支持</b> .....	11
5.4 热性能信息.....	5	9.1 文档支持.....	11
5.5 电气特性.....	5	9.2 接收文档更新通知.....	11
5.6 开关特性, $V_{CC} = 3.3V \pm 0.3V$ .....	5	9.3 支持资源.....	11
5.7 开关特性, $V_{CC} = 5V \pm 0.5V$ .....	5	9.4 商标.....	11
5.8 工作特性.....	5	9.5 静电放电警告.....	11
<b>6 参数测量信息</b> .....	6	9.6 术语表.....	11
<b>7 详细说明</b> .....	7	<b>10 修订历史记录</b> .....	11
7.1 概述.....	7	<b>11 机械、封装和可订购信息</b> .....	11
7.2 功能方框图.....	7		

## 4 引脚配置和功能

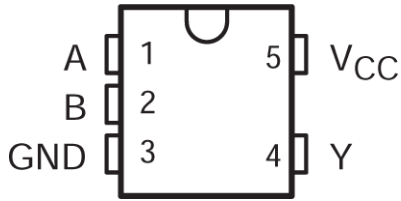


图 4-1. DBV 或 DCK 封装，5 引脚 SOT-23 或 SOT-SC70 (顶视图)

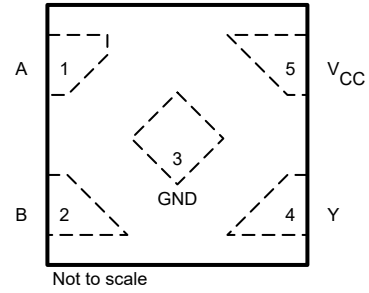


图 4-2. DTX 封装，5 引脚 X2SON (顶视图)

表 4-1. 引脚功能

引脚		类型 <sup>(1)</sup>	说明
名称	编号		
A	1	I	输入 A
B	2	I	输入 B
GND	3	—	接地引脚
Y	4	O	输出 Y
V <sub>CC</sub>	5	—	电源引脚

(1) 信号类型：I = 输入，O = 输出，I/O = 输入或输出

## 5 规格

### 5.1 绝对最大额定值

在自然通风温度下测得 (除非另有说明) <sup>(1)</sup>

		最小值	最大值	单位
V <sub>CC</sub>	电源电压范围	-0.5	7	V
V <sub>I</sub> <sup>(2)</sup>	输入电压范围	-0.5	7	V
V <sub>O</sub> <sup>(2)</sup>	输出电压范围	-0.5	V <sub>CC</sub> +0.5	V
I <sub>IK</sub>	输入钳位电流	(V <sub>I</sub> < 0)	-20	mA
I <sub>OK</sub>	输出钳位电流	(V <sub>O</sub> < 0 或 V <sub>O</sub> > V <sub>CC</sub> )	±20	mA
I <sub>O</sub>	持续输出电流	(V <sub>O</sub> = 0 至 V <sub>CC</sub> )	±25	mA
	通过 V <sub>CC</sub> 或 GND 的持续电流		±50	mA
T <sub>stg</sub>	贮存温度范围	-65	150	°C

- (1) 应力超出绝对最大额定值下列出的值可能会对器件造成损坏。这些仅为压力额定值，并不表示器件在这些条件下以及在建议的工作条件以外的任何其他条件下能够正常运行。长时间处于绝对最大额定条件下可能会影响器件的可靠性。
- (2) 如果遵守输入和输出电流额定值，输入和输出电压可超过额定值。

### 5.2 ESD 等级

		值	单位
V <sub>(ESD)</sub>	静电放电	人体放电模型 (HBM), 符合 AEC Q100-002 标准 <sup>1</sup>	±1500 V

- (1) AEC Q100-002 指示必须按照 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 规范执行 HBM 应力测试。

### 5.3 建议运行条件

在自然通风温度下测得 (除非另有说明) <sup>(1)</sup>

		最小值	最大值	单位
V <sub>CC</sub>	电源电压	2	5.5	V
V <sub>IH</sub>	高电平输入电压	V <sub>CC</sub> = 2V	1.5	V
		V <sub>CC</sub> = 3V	2.1	
		V <sub>CC</sub> = 5.5V	3.85	
V <sub>IL</sub>	低电平输入电压	V <sub>CC</sub> = 2V	0.5	V
		V <sub>CC</sub> = 3V	0.9	
		V <sub>CC</sub> = 5.5V	1.65	
V <sub>I</sub>	输入电压	0	5.5	V
V <sub>O</sub>	输出电压	0	V <sub>CC</sub>	V
I <sub>OH</sub>	高电平输出电流	V <sub>CC</sub> = 2V	-50	μA
		V <sub>CC</sub> =3.3V±0.3V	-4	mA
		V <sub>CC</sub> =5V±0.5V	-8	
I <sub>OL</sub>	低电平输出电流	V <sub>CC</sub> = 2V	50	μA
		V <sub>CC</sub> =3.3V±0.3V	4	mA
		V <sub>CC</sub> =5V±0.5V	8	
Δt/Δv	输入转换上升或下降速率	V <sub>CC</sub> =3.3V±0.3V	100	ns/V
		V <sub>CC</sub> = 5V ± 0.5V	20	
T <sub>A</sub>	自然通风条件下的工作温度范围 (SN74AHC1G32-Q1T)	-40	105	°C
T <sub>A</sub>	自然通风条件下的工作温度范围 (SN74AHC1G32-Q1Q)	-40	125	°C

- (1) 器件所有的未使用输入必须保持在 V<sub>CC</sub> 或 GND 以确保器件正常运行。请参阅 TI 应用报告 *CMOS 输入缓慢变化或悬空的影响*, 文献编号 SCBA004。

## 5.4 热性能信息

热指标 <sup>(1)</sup>	SN74AHC1G32-Q1			单位
	DBV	DCK	DTX	
	5 引脚	5 引脚	5 引脚	
R <sub>θJA</sub> 结至环境热阻	278	289.2	184.7	°C/W

(1) 有关新旧热指标的更多信息, 请参阅 *IC 封装热指标* 应用报告 (SPRA953)。

## 5.5 电气特性

在推荐的自然通风条件下的工作温度范围内测得 (除非另外注明)

参数	测试条件	V <sub>CC</sub>	T <sub>A</sub> = 25°C			最小值	最大值	单位
			最小值	典型值	最大值			
V <sub>OH</sub>	I <sub>OH</sub> = -50 μA	2V	1.9	2		1.9	V	
		3V	2.9	3		2.9		
		4.5V	4.4	4.5		4.4		
	I <sub>OH</sub> = -4mA	3V	2.58			2.48		
	I <sub>OH</sub> = -8mA	4.5V	3.94			3.8		
V <sub>OL</sub>	I <sub>OL</sub> = 50 μA	2V			0.1	0.1	V	
		3V			0.1	0.1		
		4.5V			0.1	0.1		
	I <sub>OL</sub> = 4mA	3V			0.36	0.44		
	I <sub>OL</sub> = 8mA	4.5V			0.36	0.44		
I <sub>I</sub>	V <sub>I</sub> = 5.5V 或 GND	0V 至 5.5V			±0.1	±1	μA	
I <sub>CC</sub>	V <sub>I</sub> = V <sub>CC</sub> 或 GND, I <sub>O</sub> = 0	5.5V			1	10	μA	
C <sub>i</sub>	V <sub>I</sub> = V <sub>CC</sub> 或 GND	5V		2	10	10	pF	

## 5.6 开关特性, V<sub>CC</sub> = 3.3V ± 0.3V

在推荐的自然通风条件下的工作温度范围内测得, V<sub>CC</sub> = 3.3V ± 0.3V (除非另有说明) (请参阅 [负载电路和电压波形](#))

参数	从 (输入)	至 (输出)	负载电容	T <sub>A</sub> = 25°C			最小值	最大值	单位
				最小值	典型值	最大值			
t <sub>PLH</sub>	A 或 B	Y	C <sub>L</sub> = 50pF		8	11.4	1	13	ns
t <sub>PHL</sub>					8	11.4	1	13	

## 5.7 开关特性, V<sub>CC</sub> = 5V ± 0.5V

在推荐的自然通风条件下的工作温度范围内测得, V<sub>CC</sub> = 5V ± 0.5V (除非另有说明) (请参阅 [负载电路和电压波形](#))

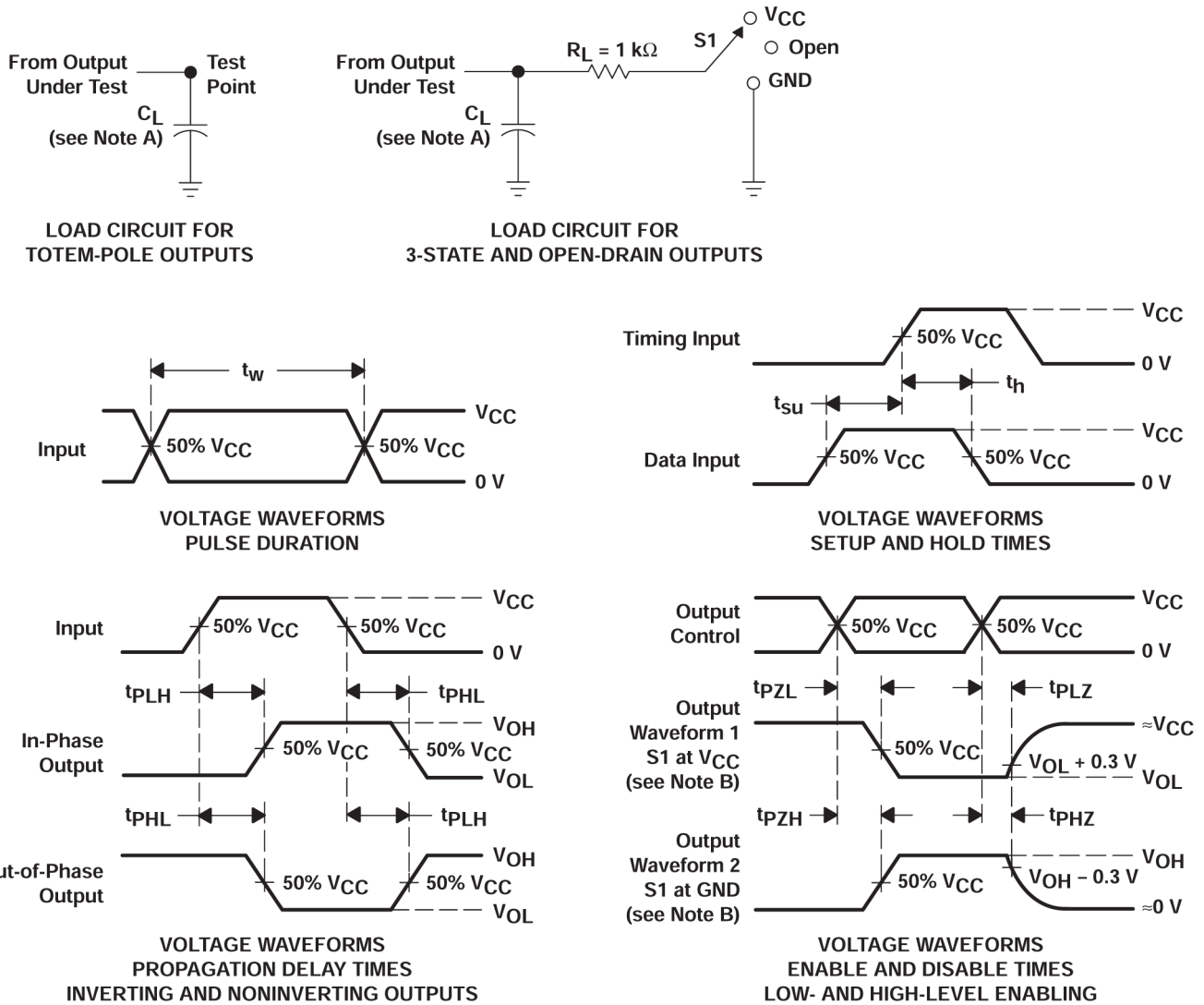
参数	从 (输入)	至 (输出)	负载电容	T <sub>A</sub> = 25°C			最小值	最大值	单位
				最小值	典型值	最大值			
t <sub>PLH</sub>	A 或 B	Y	C <sub>L</sub> = 50pF		5.3	7.5	1	8.5	ns
t <sub>PHL</sub>					5.3	7.5	1	8.5	

## 5.8 工作特性

V<sub>CC</sub> = 5V, T<sub>A</sub> = 25°C

参数	测试条件	典型值	单位
C <sub>pd</sub> 功率耗散电容	无负载, f = 1MHz	14	pF

## 6 参数测量信息



- A.  $C_L$  包括探头和夹具电容。
- B. 波形 1 用于具有内部条件的输出，使得输出为低电平，除非被输出控制禁用。波形 2 用于具有内部条件的输出，使得输出为高电平，除非被输出控制禁用。
- C. 所有输入脉冲由具有以下特性的发生器提供： $PRR \leq 1\text{MHz}$ ， $Z_O = 50\ \Omega$ ， $t_r \leq 3\text{ns}$ ， $t_f \leq 3\text{ns}$ 。
- D. 一次测量一个输出，每次测量一个输入转换。
- E. 并非所有参数和波形都适用于所有器件。

图 6-1. 负载电路和电压波形

测试	S1
$t_{PLH}/t_{PHL}$	开路
$t_{PLZ}/t_{PZL}$	$V_{CC}$
$t_{PHZ}/t_{PZH}$	GND
漏极开路	$V_{CC}$

## 7 详细说明

### 7.1 概述

该器件包含一个 2 输入或门。逻辑门以正逻辑执行布尔函数  $Y = A + B$ 。输出电平以电源电压 ( $V_{CC}$ ) 为基准，并且支持 2.0V、3.0V 和 5V CMOS 电平。

### 7.2 功能方框图



图 7-1. 逻辑图 (正逻辑)

### 7.3 特性说明

#### 7.3.1 标准 CMOS 输入

此器件包括标准 CMOS 输入。标准 CMOS 输入为高阻抗，通常建模为与输入电容并联的电阻器，如 *电气特性* 中所示。最坏情况下的电阻是根据 *绝对最大额定值* 中给出的最大输入电压和 *电气特性* 中给出的最大输入漏电流，使用欧姆定律 ( $R = V \div I$ ) 计算得出的。

标准 CMOS 输入要求输入信号在有效逻辑状态之间快速转换，如 *建议运行条件* 表中的输入转换时间或速率所定义。不符合此规范将导致功耗过大并可能导致振荡。更多详细信息，请参阅 [CMOS 输入缓慢或悬空的影响](#)。

在运行期间，任何时候都不要让标准 CMOS 输入悬空。未使用的输入必须在  $V_{CC}$  或 GND 端接。如果系统不会一直主动驱动输入，则可以添加上拉或下拉电阻器，以在这些时间段提供有效的输入电压。电阻值将取决于多种因素；但建议使用 10k $\Omega$  电阻器，这通常可以满足所有要求。

#### 7.3.2 平衡 CMOS 推挽式输出

该器件包括平衡 CMOS 推挽输出。术语 *平衡* 表示器件可以灌入和拉出相似的电流。此器件的驱动能力可能在轻负载时产生快速边缘，因此应考虑布线和负载条件以防止振铃。此外，该器件的输出能够驱动的电流比此器件能够承受的电流更大，而不会损坏器件。务必限制器件的输出功率，以避免因过流而损坏器件。必须始终遵守 *绝对最大额定值* 中规定的电气和热限值。

未使用的推挽 CMOS 输出必须保持断开状态。

### 7.3.3 钳位二极管结构

该器件的输出同时具有正负钳位二极管，而该器件的输入只有负钳位二极管，如图 7-2 所示。

**小心**

电压超出绝对最大额定值表中规定的值可能会损坏器件。如果遵守输入和输出钳制电流额定值，输入和输出电压可超过额定值。

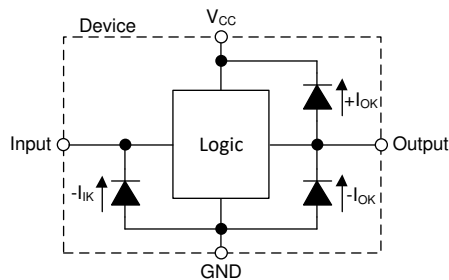


图 7-2. 每个输入和输出的钳位二极管的电气布置

### 7.4 器件功能模式

表 7-1. 功能表

输入 <sup>(1)</sup>		输出 Y
A	B	
H	X	H
X	H	H
L	L	L

(1) H = 高电压电平, L = 低电压电平, X = 不用考虑



## 8 应用和实施

### 备注

以下应用部分中的信息不属于 TI 元件规格，TI 不担保其准确性和完整性。TI 的客户负责确定元件是否适合其用途，以及验证和测试其设计实现以确认系统功能。

### 8.1 应用信息

在该应用中，将三个双输入或门相组合，可实现 4 输入或门的功能，如典型应用方框图所示。第四个门可用于系统中的另一个应用，或者可将输入接地，不使用该通道。

SN74AHC1G32-Q1 器件用于直接控制风扇驱动器的使能引脚。要启用风扇驱动器，仅需一个输入信号处于高电平即可，并且在所有信号变为低电平时应禁用风扇驱动器。4 输入或门功能将四个单独的过热信号组合成一个高电平有效使能信号。

温度传感器通常会分布在整个系统中，并非集中在同一位置。这样一来，需要更长的布线或导线来传递信号，会导致边沿转换变慢。这使得 SN74AHC1G32-Q1 对于组合传入信号非常有用。

### 8.2 典型应用

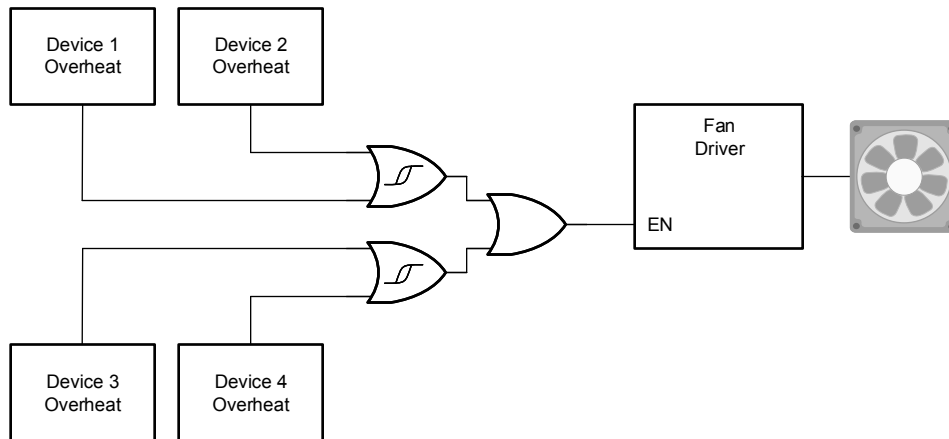


图 8-1. 典型应用框图

#### 8.2.1 设计要求

#### 8.2.2 详细设计过程

1. 在  $V_{CC}$  至  $GND$  之间添加一个去耦电容器。此电容器需要在物理上靠近器件，在电气上靠近  $V_{CC}$  和  $GND$  引脚。布局部分中显示了示例布局。
2. 确保输出端的容性负载  $\leq 50\text{pF}$ 。这不是硬性限制；但是，根据设计，该限制将优化性能。这可以通过从 SN74AHC1G32-Q1 向一个或多个接收器件提供适当大小的短布线来实现。
3. 确保输出端的电阻负载大于  $(V_{CC}/I_{O(max)}) \Omega$ 。这可防止超出绝对最大额定值中的最大输出电流。大多数 CMOS 输入具有以  $M\Omega$  为单位的电阻负载；远大于之前计算的最小值。
4. 逻辑门很少关注热问题；然而，可以使用应用报告 CMOS 功耗与 Cpd 计算中提供的步骤计算功耗和热增量。

### 8.2.3 应用曲线

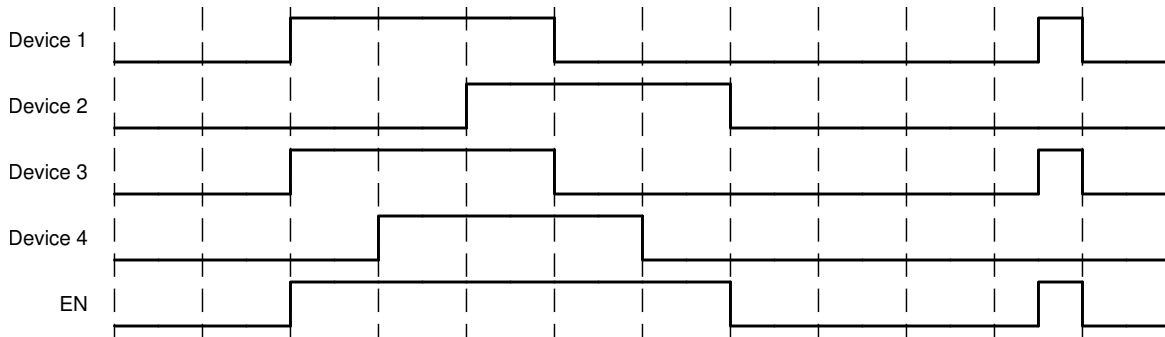


图 8-2. 应用时序图

### 8.3 电源相关建议

电源可以是 *建议的工作条件* 中最小和最大电源电压额定值之间的任何电压。每个  $V_{CC}$  端子均应具有一个良好的旁路电容器，以防止功率干扰。建议为该器件使用  $0.1\ \mu\text{F}$  电容。可以并联多个旁路电容器以抑制不同的噪声频率。 $0.1\ \mu\text{F}$  和  $1\ \mu\text{F}$  电容器通常并联使用。旁路电容器应安装在尽可能靠近电源端子的位置，以获得更佳效果，如以下布局示例所示。

### 8.4 布局

#### 8.4.1 布局指南

使用多输入和多通道逻辑器件时，输入不得悬空。在许多情况下，未使用数字逻辑器件的功能或部分功能（例如，当仅使用三输入与门的两个输入或仅使用 4 个缓冲门中的 3 个时）。此类未使用的输入引脚不得悬空，因为外部连接处的未定义电压会导致未定义的操作状态。数字逻辑器件的所有未使用输入必须连接到由输入电压规范定义的逻辑高电平电压或逻辑低电平电压，以防止其悬空。必须应用于任何特定未使用输入的逻辑电平取决于器件的功能。通常，输入连接到  $GND$  或  $V_{CC}$ ，以对逻辑功能更有意义或更方便者为准。

#### 8.4.2 布局示例

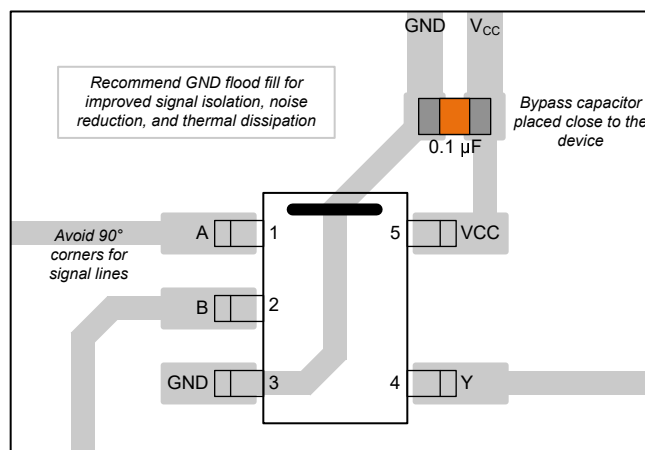


图 8-3. SN74AHC1G32-Q1 的示例布局

## 9 器件和文档支持

### 9.1 文档支持

#### 9.1.1 相关文档

请参阅如下相关文档：

- 德州仪器 (TI)，[慢速或浮点 CMOS 输入的影响](#)

### 9.2 接收文档更新通知

要接收文档更新通知，请导航至 [ti.com](#) 上的器件产品文件夹。点击 [通知](#) 进行注册，即可每周接收产品信息更改摘要。有关更改的详细信息，请查看任何已修订文档中包含的修订历史记录。

### 9.3 支持资源

[TI E2E™ 中文支持论坛](#) 是工程师的重要参考资料，可直接从专家处获得快速、经过验证的解答和设计帮助。搜索现有解答或提出自己的问题，获得所需的快速设计帮助。

链接的内容由各个贡献者“按原样”提供。这些内容并不构成 TI 技术规范，并且不一定反映 TI 的观点；请参阅 TI 的 [使用条款](#)。

### 9.4 商标

TI E2E™ is a trademark of Texas Instruments.

所有商标均为其各自所有者的财产。

### 9.5 静电放电警告



静电放电 (ESD) 会损坏这个集成电路。德州仪器 (TI) 建议通过适当的预防措施处理所有集成电路。如果不遵守正确的处理和安装程序，可能会损坏集成电路。

ESD 的损坏小至导致微小的性能降级，大至整个器件故障。精密的集成电路可能更容易受到损坏，这是因为非常细微的参数更改都可能会导致器件与其发布的规格不相符。

### 9.6 术语表

[TI 术语表](#) 本术语表列出并解释了术语、首字母缩略词和定义。

## 10 修订历史记录

注：以前版本的页码可能与当前版本的页码不同

### Changes from Revision D (January 2024) to Revision E (October 2024) Page

- 向 [封装信息表](#)、[引脚配置和功能](#) 部分以及 [热性能信息表](#) 中添加了 DTX 封装..... 1

### Changes from Revision C (October 2023) to Revision D (January 2024) Page

- 向 [特性](#) 部分中添加了 ESD 分类..... 1
- 更新了 R<sub>θJA</sub> 值：DBV = 206 至 278，所有值均以 °C/W 为单位..... 5

## 11 机械、封装和可订购信息

下述页面包含机械、封装和订购信息。这些信息是指定器件可用的最新数据。数据如有变更，恕不另行通知，且不会对此文档进行修订。有关此数据表的浏览器版本，请查阅左侧的导航栏。

**PACKAGING INFORMATION**

Orderable Device	Status (1)	Package Type	Package Drawing	Pins	Package Qty	Eco Plan (2)	Lead finish/ Ball material (6)	MSL Peak Temp (3)	Op Temp (°C)	Device Marking (4/5)	Samples
SN74AHC1G32QDBVRQ1	ACTIVE	SOT-23	DBV	5	3000	RoHS & Green	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	39DH	<a href="#">Samples</a>
SN74AHC1G32QDCKRQ1	ACTIVE	SC70	DCK	5	3000	RoHS & Green	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	1OF	<a href="#">Samples</a>
SN74AHC1G32TDBVRQ1	ACTIVE	SOT-23	DBV	5	3000	RoHS & Green	NIPDAU   SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 105	(39GH, A32U)	<a href="#">Samples</a>
SN74AHC1G32TDCKRQ1	ACTIVE	SC70	DCK	5	3000	RoHS & Green	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 105	AGU	<a href="#">Samples</a>

(1) The marketing status values are defined as follows:

**ACTIVE:** Product device recommended for new designs.

**LIFEBUY:** TI has announced that the device will be discontinued, and a lifetime-buy period is in effect.

**NRND:** Not recommended for new designs. Device is in production to support existing customers, but TI does not recommend using this part in a new design.

**PREVIEW:** Device has been announced but is not in production. Samples may or may not be available.

**OBSELETE:** TI has discontinued the production of the device.

(2) **RoHS:** TI defines "RoHS" to mean semiconductor products that are compliant with the current EU RoHS requirements for all 10 RoHS substances, including the requirement that RoHS substance do not exceed 0.1% by weight in homogeneous materials. Where designed to be soldered at high temperatures, "RoHS" products are suitable for use in specified lead-free processes. TI may reference these types of products as "Pb-Free".

**RoHS Exempt:** TI defines "RoHS Exempt" to mean products that contain lead but are compliant with EU RoHS pursuant to a specific EU RoHS exemption.

**Green:** TI defines "Green" to mean the content of Chlorine (Cl) and Bromine (Br) based flame retardants meet JS709B low halogen requirements of <=1000ppm threshold. Antimony trioxide based flame retardants must also meet the <=1000ppm threshold requirement.

(3) MSL, Peak Temp. - The Moisture Sensitivity Level rating according to the JEDEC industry standard classifications, and peak solder temperature.

(4) There may be additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category on the device.

(5) Multiple Device Markings will be inside parentheses. Only one Device Marking contained in parentheses and separated by a "-" will appear on a device. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire Device Marking for that device.

(6) Lead finish/Ball material - Orderable Devices may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.

**Important Information and Disclaimer:**The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and

continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.

**OTHER QUALIFIED VERSIONS OF SN74AHC1G32-Q1 :**

- Catalog : [SN74AHC1G32](#)

NOTE: Qualified Version Definitions:

- Catalog - TI's standard catalog product

**TAPE AND REEL INFORMATION**

**QUADRANT ASSIGNMENTS FOR PIN 1 ORIENTATION IN TAPE**


\*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Reel Diameter (mm)	Reel Width W1 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P1 (mm)	W (mm)	Pin1 Quadrant
SN74AHC1G32QDBVRQ1	SOT-23	DBV	5	3000	180.0	8.4	3.2	3.2	1.4	4.0	8.0	Q3
SN74AHC1G32QDCKRQ1	SC70	DCK	5	3000	178.0	9.0	2.4	2.5	1.2	4.0	8.0	Q3
SN74AHC1G32TDBVRQ1	SOT-23	DBV	5	3000	179.0	8.4	3.2	3.2	1.4	4.0	8.0	Q3
SN74AHC1G32TDCKRQ1	SC70	DCK	5	3000	178.0	9.0	2.4	2.5	1.2	4.0	8.0	Q3

## TAPE AND REEL BOX DIMENSIONS



\*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)
SN74AHC1G32QDBVRQ1	SOT-23	DBV	5	3000	210.0	185.0	35.0
SN74AHC1G32QDCKRQ1	SC70	DCK	5	3000	190.0	190.0	30.0
SN74AHC1G32TDBVRQ1	SOT-23	DBV	5	3000	200.0	183.0	25.0
SN74AHC1G32TDCKRQ1	SC70	DCK	5	3000	190.0	190.0	30.0



# DBV0005A

# PACKAGE OUTLINE

## SOT-23 - 1.45 mm max height

SMALL OUTLINE TRANSISTOR



4214839/K 08/2024

**NOTES:**

1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. Reference JEDEC MO-178.
4. Body dimensions do not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed 0.25 mm per side.
5. Support pin may differ or may not be present.



# EXAMPLE BOARD LAYOUT

DBV0005A

SOT-23 - 1.45 mm max height

SMALL OUTLINE TRANSISTOR



LAND PATTERN EXAMPLE  
EXPOSED METAL SHOWN  
SCALE:15X



SOLDER MASK DETAILS

4214839/K 08/2024

NOTES: (continued)

- 6. Publication IPC-7351 may have alternate designs.
- 7. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.

# EXAMPLE STENCIL DESIGN

DBV0005A

SOT-23 - 1.45 mm max height

SMALL OUTLINE TRANSISTOR



SOLDER PASTE EXAMPLE  
BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL  
SCALE:15X

4214839/K 08/2024

NOTES: (continued)

8. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
9. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

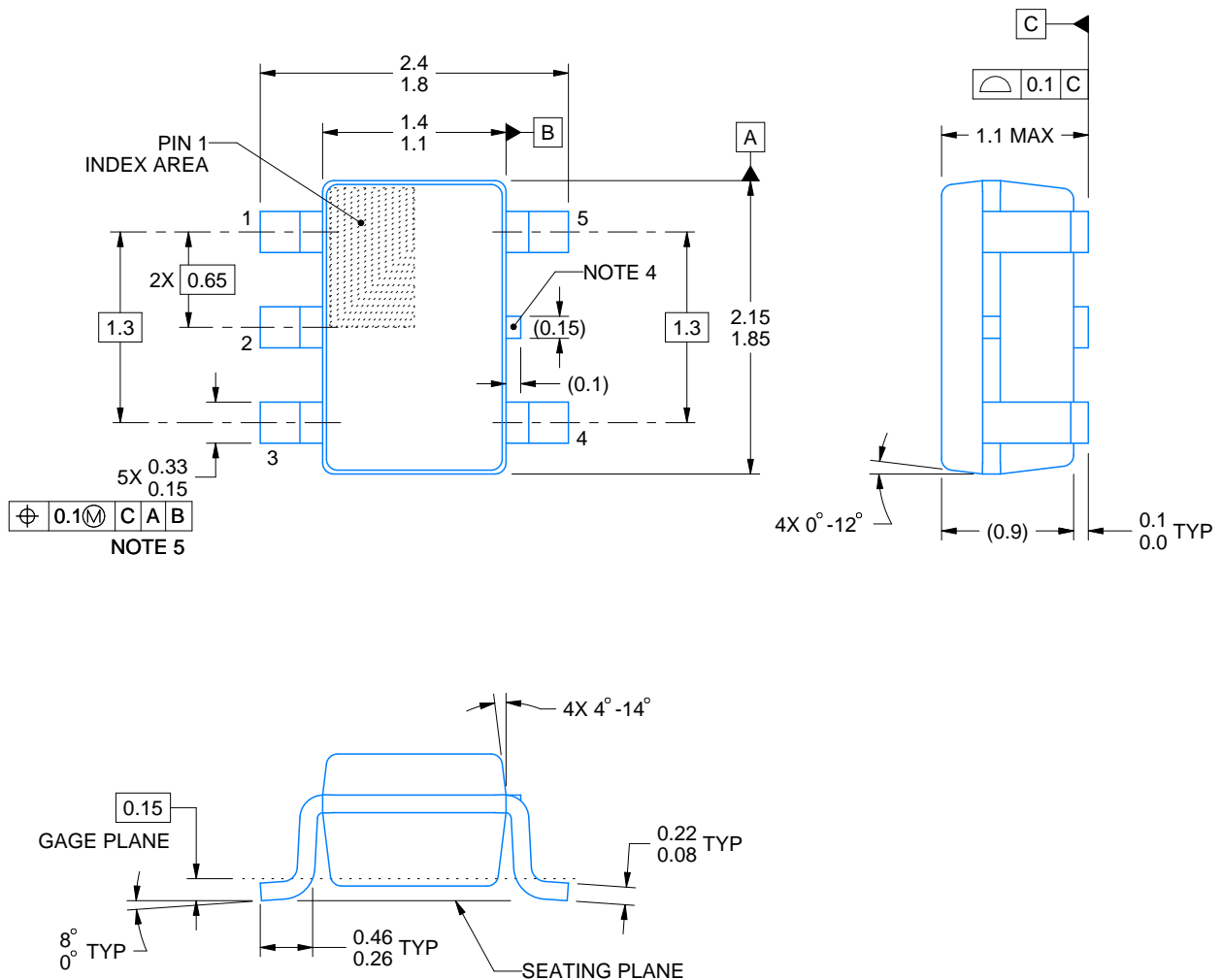
# DCK0005A



# PACKAGE OUTLINE

SOT - 1.1 max height

SMALL OUTLINE TRANSISTOR



4214834/F 08/2024

## NOTES:

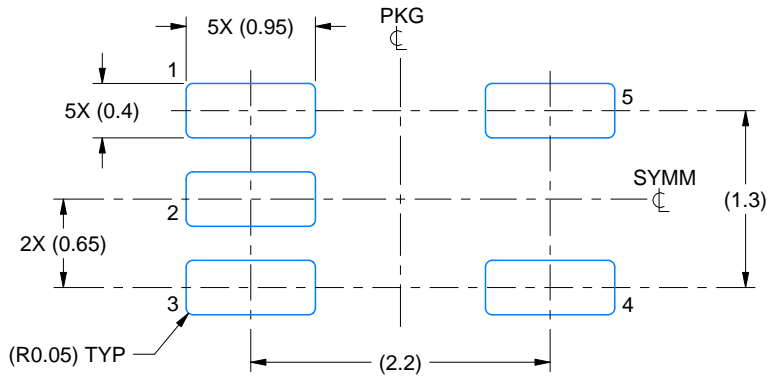
1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. Reference JEDEC MO-203.
4. Support pin may differ or may not be present.
5. Lead width does not comply with JEDEC.
6. Body dimensions do not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed 0.25mm per side

# EXAMPLE BOARD LAYOUT

DCK0005A

SOT - 1.1 max height

SMALL OUTLINE TRANSISTOR



LAND PATTERN EXAMPLE  
EXPOSED METAL SHOWN  
SCALE:18X



SOLDER MASK DETAILS

4214834/F 08/2024

NOTES: (continued)

- 7. Publication IPC-7351 may have alternate designs.
- 8. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.

# EXAMPLE STENCIL DESIGN

DCK0005A

SOT - 1.1 max height

SMALL OUTLINE TRANSISTOR



SOLDER PASTE EXAMPLE  
BASED ON 0.125 THICK STENCIL  
SCALE: 18X

4214834/F 08/2024

NOTES: (continued)

9. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
10. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

## 重要声明和免责声明

TI“按原样”提供技术和可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源，不保证没有瑕疵且不做任何明示或暗示的担保，包括但不限于对适销性、某特定用途方面的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任：(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品，(2) 设计、验证并测试您的应用，(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他功能安全、信息安全、监管或其他要求。

这些资源如有变更，恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的应用。严禁对这些资源进行其他复制或展示。您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。您应全额赔偿因在这些资源的使用中对 TI 及其代表造成的任何索赔、损害、成本、损失和债务，TI 对此概不负责。

TI 提供的产品受 [TI 的销售条款](#) 或 [ti.com](#) 上其他适用条款/TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。

TI 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。

邮寄地址：Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265  
Copyright © 2024，德州仪器 (TI) 公司